© EPODOC / EPO

PN - JP58217901 A 19831219

PD - 1983-12-19

PR - JP19820100789 19820614

OPD - 1982-06-14

TI - (A)

LAMINATE VAPOR-DEPOSITED ON BOTH SIDES

AB - (A)

PURPOSE:To easily obtain both side vapor deposition laminates free from strain without requiring any pretreatment or the like, by correcting strain produced in a base due to the first vapor deposited film formed on one side through formation of the second vapor deposited film on the other side. CONSTITUTION: For example, in forming a thin high-reflectance mirror material, a layer H of high refractive index material, such as TiO2, and a layer L of low index material, such as SiO2 are alternately laminated on the first free 31a of the base glass 31 to form a high-reflectance mirror 32, and MgF2 is vapor deposited onto the second face 31b of the glass 31 so as to form an MgF2 vapor deposited film 22, 23 as the second vapor deposited film also used as prevention of reflection having a thickenss thick enough to erase the strain of the glass 31 due to the formation of the mirror 32. Said example is the case of the base strained by the tensile stress of the first film, but when the first film generates compressive stress, a vapor deposition film exhibiting compressive stress, such as SiO2, may be used as the second vapor deposition film.

IN - (A)

YAMAMURA NORIO; KANEKO MASAAKI

PA - (A)

NIPPON KOGAKU KK

EC - G02B1/10C

IC - (A)

G02B1/10

CT - (B)

JP57085972 A []

© PAJ / JPO

PN - JP58217901 A 19831219

PD - 1983-12-19

AP - JP19820100789 19820614 IN - YAMAMURA NORIO; others: 01

Page 1

PA - NIHON KOUGAKU KOGYO KK

AB

- TI LAMINATE VAPOR-DEPOSITED ON BOTH SIDES
 - PURPOSE:To easily obtain both side vapor deposition laminates free from strain without requiring any pretreatment or the like, by correcting strain produced in a base due to the first vapor deposited film formed on one side through formation of the second vapor deposited film on the other side.
 - CONSTITUTION:For example, in forming a thin high-reflectance mirror material, a layer H of high refractive index material, such as TiO2, and a layer L of low index material, such as SiO2 are alternately laminated on the first free 31a of the base glass 31 to form a high-reflectance mirror 32, and MgF2 is vapor deposited onto the second face 31b of the glass 31 so as to form an MgF2 vapor deposited film 22, 23 as the second vapor deposited film also used as prevention of reflection having a thickenss thick enough to erase the strain of the glass 31 due to the formation of the mirror 32. Said example is the case of the base strained by the tensile stress of the first film, but when the first film generates compressive stress, a vapor deposition film exhibiting compressive stress, such as SiO2, may be used as the second vapor deposition film.
 - G02B1/10

(1) 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

⑫公開特許公報(A)

昭58-217901

f)Int. Cl.³
G 02 B 1/10

識別記号

庁内整理番号 8106-2H ❸公開 昭和58年(1983)12月19日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 4 頁)

國両面蒸着積層物

の特

顧 昭57—100789

②出 願 昭57(1982)6月14日

70発 明 者 山村則夫

川崎市高津区新作1-62

⑩発 明 者 金子正昭

東京都世田谷区玉川台 2 --24--15

⑪出 願 人 日本光学工業株式会社

東京都千代田区丸の内3丁目2

番3号

個代 理 人 弁理士 岡部正夫

外5名

明 細 報

1. 発明の名称

两面蒸着積層物

2.特許請求の範囲

悲板の一側に蒸着された内部応力を有する 第1蒸漪膜、前記内部応力により歪みを起こ 寸基板及び前記第1蒸漪膜とは反対側に蒸着 され、第1蒸漪膜の有する内部応力と釣合つ た内部応力を有する第2蒸着膜から成ること を特徴とする両面蒸着積層物。

3. 発明の詳細な説明

本発明は、蒸着膜の内部応力による恭板面 の歪みを補正した両面蒸着積層物に関するも のである。

従来より典空蒸着ヤスパツタリング法などにより基板上に形成された蒸箱 薄膜中には、場合によつてその基板面を歪ませる程の大きな内部応力が存在することが知られている(例えば、Trans. 8th Natl. Vacuum Symp. 1961年刊 P943~)。

との蒸着膜中の内部応力により、その両面が平面状に研磨加工された基板 1 1 (第1図(a))は、これが非常に薄い場合、外部から検知されるほどに変形する。変形には第1図(b) 又は(c)に示す如く、蒸着膜12の個別によって引張応力による場合(第1図(c))がある。

厳密に言えば、同じ物質からなる蒸光膜であつても、その蒸発は(例えば真空蒸光、スパッタリング、CVDなど)や、蒸発時の個々の条件(例えば基板温度、蒸溶底、真空度、蒸発源と基板との位置関係など)が異なれば、蒸溶膜12の内部に発生する内部に力、ひいては基板11の歪み最も変わつてしまり。

蒸着膜中の内部応力と共板面の歪み脂との 関係については既に解析され、以下の式で派 されるととが知られている(A. E. C. Technical Report 低15,1961年刊)。 冼板が矩形 断面の場合には、

即ち、第1面蒸着層の膜応力のバラツキや 蒸着前の基板面研磨仕上り状態(而精度)の バラツキがあつても、後の第2面蒸着で補正 できるので製造工程が比較的楽になり、且つ 高い基板面精度が得られる。

以下に本発明の実施例を示す。

とで花板ガラス31は、その厚みが 0.6 mm と称いものを用い、両面蒸着積層物の構造は 第3図に示す様に第1面31 a に高屈折率物 質からなる H 層と低屈折率物質からなる L 層

1.7×10° dyn/dlを示すことが確かめられた。そこで、上記高反射ミラー 3 2 による 引張応力と釣合わせるためにはおよそ 2500 Å のMFz膜を形成すれば良いことが予測された。

 とを交互に組み合わせた高反射ミラー32を 形成し(ここで言う高屈折率、低屈折率とは 基板ガラスの屈折率に対しての意味である)、 それとは反対傾の第2面31bに単層反射防止層膜 33を形成してなる。

高反射ミラー32の構成は、H層として

10.1、 L層として SiO.2 を用い、ガラス基板

3 1 上に H層と L層を交互に 6 組形成し最後
にH層をもう一層形成してなる (第 4 図参照)。
各々の層は、電子ビームによる一般的な真空
蒸着法で形成し、その厚さは、10.2 層 580 人、

SiO.2 層 900 人である。その結果、発生した膜
応力は、引張応力 4.5 × 1 0 4 dyn/cdであつ

た。

次に、上記高反射ミラー32による引張応力によつて生じた基板31の歪みを補正する目的で、基板の反対面31bに、同じ引張応力を示し、且つ反射防止の役割をも果す低屈折率の場下。単層膜を蒸着した。場下。膜は、予め実験により厚さ約950人で内部引張応力

厚 1 0 0 0 Å での圧縮応力値はおよそ 2 6 × 1 0 4 dyn / cd であつた。

また、本発明は積層物が光学部材(反射ミラー、レンズ、フィルタ等)である場合には 反射式でも透過式でも良いことは前述の通り である。また積層物は光学部材でなくとも良い いととは言うまでもない。

以上述べてきたように、本発明によれば、 第1蒸着膜の内部応力による基板の歪みが第 2蒸着膜によつて補正され、この第2蒸着物 は必要に応じて後で追加蒸着することができ るので、第1蒸着膜の内部応力による基板の 歪みを考慮して最適の厚さ、種とできる。 しかもこのことが、面倒な予備実験や精度の 良い研磨加工を要することなく行なえるので、 安価にして歩留りが良くかつ秀れた積層物が 大量生産できるという効果が奏される。

4. 図面の簡単な説明

第1図(a)~(c)は従来の蒸箱による基板の頂みを説明する断面図である。